

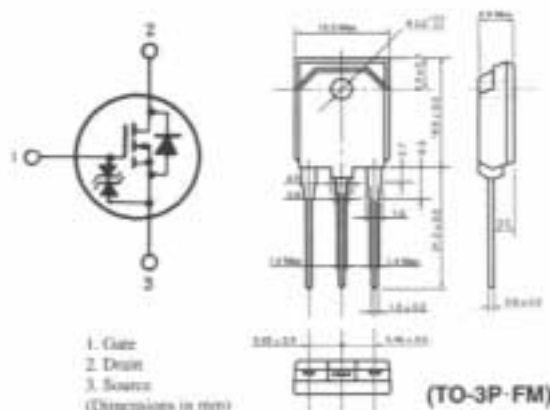
2SK1206, 2SK1225

SILICON N-CHANNEL MOS FET

高速度電力スイッチング

■ 特 長

- ・オン抵抗が低い。
- ・スイッチングスピードが速い。
- ・駆動電力が小さい。
- ・2次降伏がない。
- ・スイッチングレギュレータ、DC-DCコンバータ、モータドライバなどに最適。



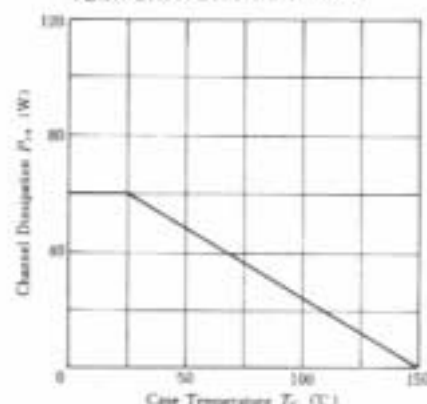
■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	2SK1225	2SK1206	Unit
Drain-Source Voltage	V_{DS}	450	500	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 20		V
Drain Current	I_D	12		A
Drain Peak Current	$I_{D(pk)}$	48		A
Body-Drain Diode Reverse Drain Current	I_{RS}	12		A
Channel Dissipation	P_{ch}	60		W
Channel Temperature	T_{ch}	150		$^\circ\text{C}$
Storage Temperature	T_{stg}	$-55 \sim +150$		$^\circ\text{C}$

*PWS10μs, duty cycle 50%

**Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

POWER VS. TEMPERATURE DERATING



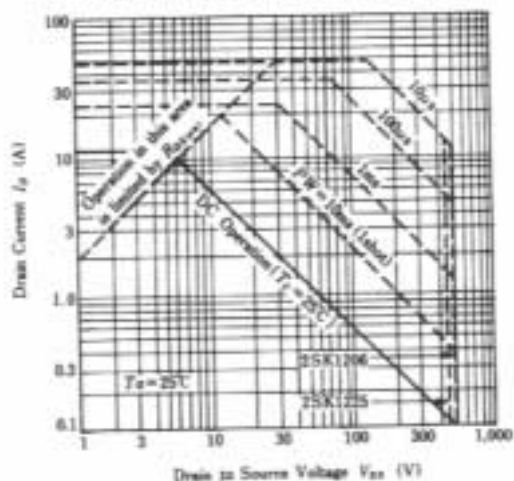
■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)DS}$	$I_D=10\text{mA}$, $V_{GS}=0$	450	—	—	V
Gate-Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)GS}$	$I_G=\pm 100\mu\text{A}$, $V_{DS}=0$	± 20	—	—	V
Gate-Source Leak Current	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 15\text{V}$, $V_{DS}=0$	—	—	± 10	μA
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS}=360\text{V}$, $V_{GS}=0$	—	—	250	μA
Gate-Source Cutoff Voltage	$V_{GS(off)}$	$I_D=1\text{mA}$, $V_{DS}=10\text{V}$	2.0	—	4.0	V
Static Drain-Source On State Resistance	$R_{DS(on)}$	$I_D=6\text{A}$, $V_{GS}=10\text{V}$ *	—	0.4	0.55	Ω
Forward Transfer Admittance	$ y_{fs} $	$I_D=6\text{A}$, $V_{DS}=10\text{V}$ *	6	10	—	S
Input Capacitance	C_{iss}	$V_{DS}=10\text{V}$, $V_{GS}=0$, $f=1\text{MHz}$	—	2050	—	pF
Output Capacitance	C_{oss}		—	720	—	pF
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}		—	80	—	pF
Turn-on Delay Time	$t_{d(on)}$	$I_D=6\text{A}$, $V_{GS}=10\text{V}$, $R_L=5\Omega$	—	25	—	ns
Rise Time	t_r		—	85	—	ns
Turn-off Delay Time	$t_{d(off)}$		—	145	—	ns
Fall Time	t_f		—	85	—	ns
Body-Drain Diode Forward Voltage	V_{SD}	$I_S=12\text{A}$, $V_{GS}=0$	—	1.0	—	V
Body-Drain Diode Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_S=12\text{A}$, $V_{GS}=0$, $dI_S/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$	—	450	—	ns

*Pulse Test

■電気的特性曲線は、2SK556, 2SK557参照。

MAXIMUM SAFE OPERATION AREA



NORMALIZED TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE VS. PULSE WIDTH

